

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING ***

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Short Channel Effect of SOI Vertical Sidewall MOSFET
 Nama/Jumlah Penulis : **Jatmiko E. Suseno**, Munawar A. Riyadi, dan Razali Ismail (3)
 Status Pengusul : Penulis pertama/~~penulis ke-.....~~ /~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : 2008 IEEE International Conference on Semiconductor Electronics (ICSE 2008)
 b. ISBN/ISSN : 978-1-4244-2560-0
 c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan : 2009, Johor Bahru, Malaysia
 DOI:10.1109/SMELEC.2008.4770370
 d. Penerbit/Organiser : IEEE
 e. Alamat repository : <https://ieeexplore.ieee.org/document/4770370>
 f. Terindeks di (jika ada) : Scopus

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : *Prosiding Forum Ilmiah Internasional*
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) *Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi*

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i>		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	2,5		2,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	7,5		7.3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	7,5		7.3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	7,5		7.2
Total = (100%)			24.3
Nilai Pengusul =	25		24.3

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal:**
Urut jurnal standar IEEE. Telah ditulis dengan baik.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:**
Bahasan sudah cukup baik, namun diskusi belum melibatkan paper dan penulis lain / referensi.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:**
Referensi masih kurang mutakhir pada saat paper terpublikasi. Metode standard dan dapat dirifikasi.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan:**
Paper terakreditasi dan konferensi terindeks, nilai max 25

$$N = 60 \times 24.3 = 14.58$$

Semarang, 10 Feb 2020
 Reviewer 1



Prof. Dr. Muhammad Nur, DEA
 NIP. 195711261990011001
 Bidang ilmu/Unit kerja : Fisika FSM UNDIP

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 **coret yang tidak perlu

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : *PROSIDING* ***

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Short Channel Effect of SOI Vertical Sidewall MOSFET
 Nama/Jumlah Penulis : **Jatmiko E. Suseno**, Munawar A. Riyadi, dan Razali Ismail (3)
 Status Pengusul : Penulis pertama/~~penulis ke.....~~ /~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : 2008 IEEE International Conference on Semiconductor Electronics (ICSE 2008)
 b. ISBN/ISSN : 978-1-4244-2560-0
 c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan : 2009, Johor Bahru, Malaysia
 DOI:10.1109/SMELEC.2008.4770370
 d. Penerbit/Organiser : IEEE
 e. Alamat repository : <https://ieeexplore.ieee.org/document/4770370>
 PT/web prosiding
 f. Terindeks di (jika ada) : Scopus

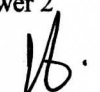
Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional
 (beri pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i>		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	2,5		2,5
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	7,5		7,2
g. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	7,5		7
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	7,5		7,5
Total = (100%)			
Nilai Pengusul =	25		24,2

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi jurnal:**
 Artikel telah di submit sesuai template dan IEEE proceeding.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:**
 Pembahasan mayoritas bersifat kuantitatif, lingkup pembahasan sesuai dengan artikel. Nilai kuantitatif perlu dibatasi untuk menghindari kebingungan dan kekeliruan.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:**
 Artikel telah di submit dengan metode penerbitan jurnal yang baik. Referensi terupdate 5 x (DOI)?
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan:**
 Artikel terbitan Scopus atau IEEE. Lengkap & terbit.

Semarang, 30 - 1 - 2020
 Reviewer 2


Prof. Dr. Heri Sutanto, MSi
 NIP. 197502151998021001
 Bidang ilmu/Unit kerja : Fisika FSM UNDIP

* dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 **coret yang tidak perlu

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING ***

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Short Channel Effect of SOI Vertical Sidewall MOSFET
 Nama/Jumlah Penulis : **Jatmiko E. Suseno, Munawar A. Riyadi, dan Razali Ismail (3)**
 Status Pengusul : Penulis pertama/penulis ke..... /penulis korespondensi **
 Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : 2008 IEEE International Conference on Semiconductor Electronics (ICSE 2008)
 b. ISBN/ISSN : 978-1-4244-2560-0
 c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan : 2009, Johor Bahru, Malaysia
 DOI:10.1109/SMELEC.2008.4770370
 d. Penerbit/Organiser : IEEE
 e. Alamat repository : <https://ieeexplore.ieee.org/document/4770370>
 PT/web prosiding
 f. Terindeks di (jika ada) : Scopus

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

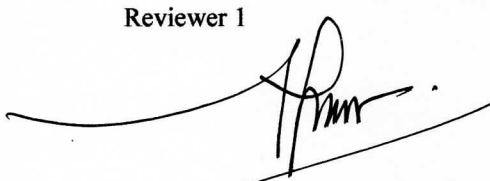
Hasil Penilaian Peer Review :


Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata-rata
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	2,5	2,5	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	7,3	7,2	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	7,3	7	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	7,2	7,5	
Total = (100%)	24,3	24,2	
Nilai untuk Pengusul :			

Semarang, 2020

Reviewer 1

Reviewer 2


 Prof. Dr. Muhammad Nur, DEA
 NIP. 195711261990011001
 Bidang ilmu/Unit kerja : Fisika FSM UNDIP


 Prof. Dr. Heri Sutanto, M.Si.
 NIP. 197502151998021001
 Bidang ilmu/Unit kerja : Fisika FSM UNDIP